

含氧量對鈦酸鑭摻鋨薄膜之晶格常數影響研究

廖罡宏、宋皇輝

E-mail: 381837@mail.dyu.edu.tw

摘要

本實驗中採用雙靶磁控射頻濺鍍法磊晶成長鈦酸鑭摻鋨薄膜($\text{Sr}_{0.16}\text{La}_{0.84}\text{TiO}_3 + \text{O}_2$)於鈦酸鋨(SrTiO_3) (001)基板上。所成長薄膜分別以不同氧分壓(10-4 torr、 6×10^{-5} torr、 4×10^{-5} torr、小於 2×10^{-5} torr)的情況下退火，以了解不同含氧量對薄膜晶格常數的影響。研究中藉由X-ray $\theta-2\theta$ 掃描，分析薄膜之c軸長度。以角不對稱掃描，分析薄膜的a、b軸長度。並將所得之鈦酸鑭摻鋨薄膜晶格常數與塊材的晶格常數分析比較。最後利用 $\sin^2\theta$ 的關係分析薄膜對不同含氧量的應力變化。

關鍵詞：鈦酸鑭摻鋨、晶格常數、磊晶成長、含氧量

目錄

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|----|---------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| 封面內頁 簽名頁 中文摘要 | iii | 英文摘要 | | | | | |
| iv 誌謝 | v | 目錄 | | | | | |
| vi 圖目錄 | viii | 表目錄 | | | | | |
| xii 第一章 緒論 1.1 前言 | 1 | 1.1.1 研究背景 | | | | | |
| 1.1.1.2 研究動機 | 2 | 第二章 樣品製備 2.1 實驗流程 | | | | | |
| 10.2.2 靶材製備 | 11 | 2.3 實驗流程敘述 | | | | | |
| 14 第三章 實驗量測原理與步驟 3.1 粉末X-ray繞射 | 16 | | | | | | |
| 3.1.1 粉末X-ray繞射原理 | 16 | 3.1.2 粉末X-ray繞射儀 | 17 | 3.2 Scan介紹 | | | |
| 18 3.2.1 掃描原理 | 18 | 3.2.2 量測儀器準備 | | | | | |
| 22 3.2.3 選擇 Scan的繞射峰(hkl) | 25 | 3.2.4 角計算敘述 | | | | | |
| 25 3.2.5 膜應變量測量實驗步驟 | 26 | 3.3 薄膜單晶樣品應變量檢測原理 | 28 | 第四章 結果與討論 4.1 薄膜樣品成長參數與結構分析 | 31 | 4.1.1 樣品a、b和c軸之估算 | 32 |
| 4.1.2 樣品薄膜的應變分析 | 52 | 第五章 結論 | 56 | 參考文獻 | | | |
| | 57 | | | | | | |

參考文獻

- [1] S. Leoni, L. Craco, A. Ormeci, and H. Rosner, Solid State Sciences 8, 1138-1143 (2006) [2] Masatoshi Imada, Atsushi Fulimori, Yoshinori Tokura, Rev. Mod. Phys., 70, 1059 (2008) [3] Franklin J. Wong, Seung-Hyub Baek, Rajesh V. Chopdekar, Virat V. Mehta, Ho-Won Jang, Chang-Beom Eom, and Yuri Suzuki, Phys. Rev. B 81, 161101(R) (2010) [4] Joseph E. Sunstrom IV, Susan M. Kauzlarich, and Peter Klavins, Chem. Mater. 4, 346-353(1992) [5] S. A. Howard, J. K. Yau, and H.U. Anderson, J. Appl. Phys. 65 (1989) [6] S. L. Yan, L Fang, M. S. Si, H.L. Cao, Q.X. Song, J Yan, X.D. Zhou, J.M. Hao Supercond. Sci. Technol 7, 681 - 684 (1994) [7] Bing H. Hwang, S.Y. Chiou, Thin Solid Films 304, 286-293 (1997) [8] Lamartine Meda, Klaus H. Dahmen, Saaleh Hayek, Hamid Garmestani, Journal of Crystal Growth 263, 185 (2004) [9] 林政學，“應力對鈦酸鑭?鋨薄膜之傳輸特性研究”，大葉大學碩士論文,2010 [10] 蔡俊璋，“鈦酸鑭薄膜成長於不同基座之X光?暎干涉及應變研究”，大葉大學碩士論文,2011 [11] 吳翼貽，“儀中心簡訊”，第十三卷第六期，1992 [12] 許樹恩、吳泰伯，“X光繞射原理與材料結構分析”，中國材料科學學會 [13] B. D. Cullity, S. R. Stock, “Elements of X-ray diffraction” Pearson Prentice Hall, (2001) [14] 許樹恩、吳泰伯，“X光繞射原理與材料結構分析”，中國材料科學學會 [15] B. D. Cullity, S. R. Stock, “Elements of X-ray diffraction” Pearson Prentice Hall, (2001) [16] 美國國家標準和技術院(National Institute for Standards and Technology, NIST) [17] A.Ohtomo, D.A. Muller, J. L. Grazul, and H. Y. Hwang, Appl. Phys. Lett. 80, 3922 (2002) [18] Masahito Mochizuki, Masatoshi Imada, New Journal of Physics 6, 154 (2004) [19] S. Liang, D.J. Wang, J.R. Sun, and B.G. Shen, Solid State Communication 148, 386 (2008) [20] 黃晨益，“含氧量對鈦酸鑭摻鋨薄膜之傳輸特性研究”，大葉大學碩士論文,2013